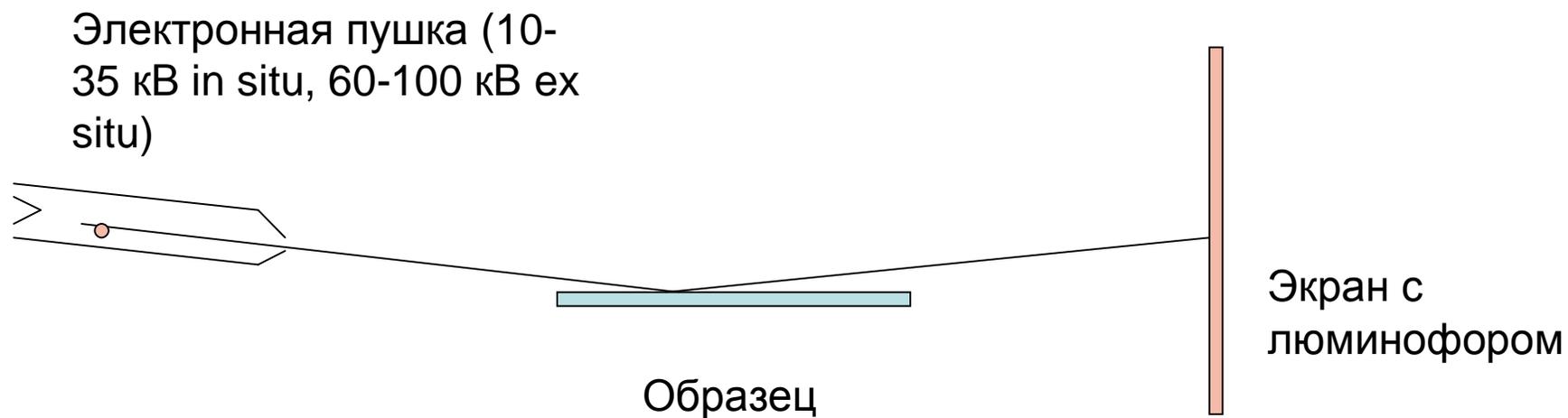


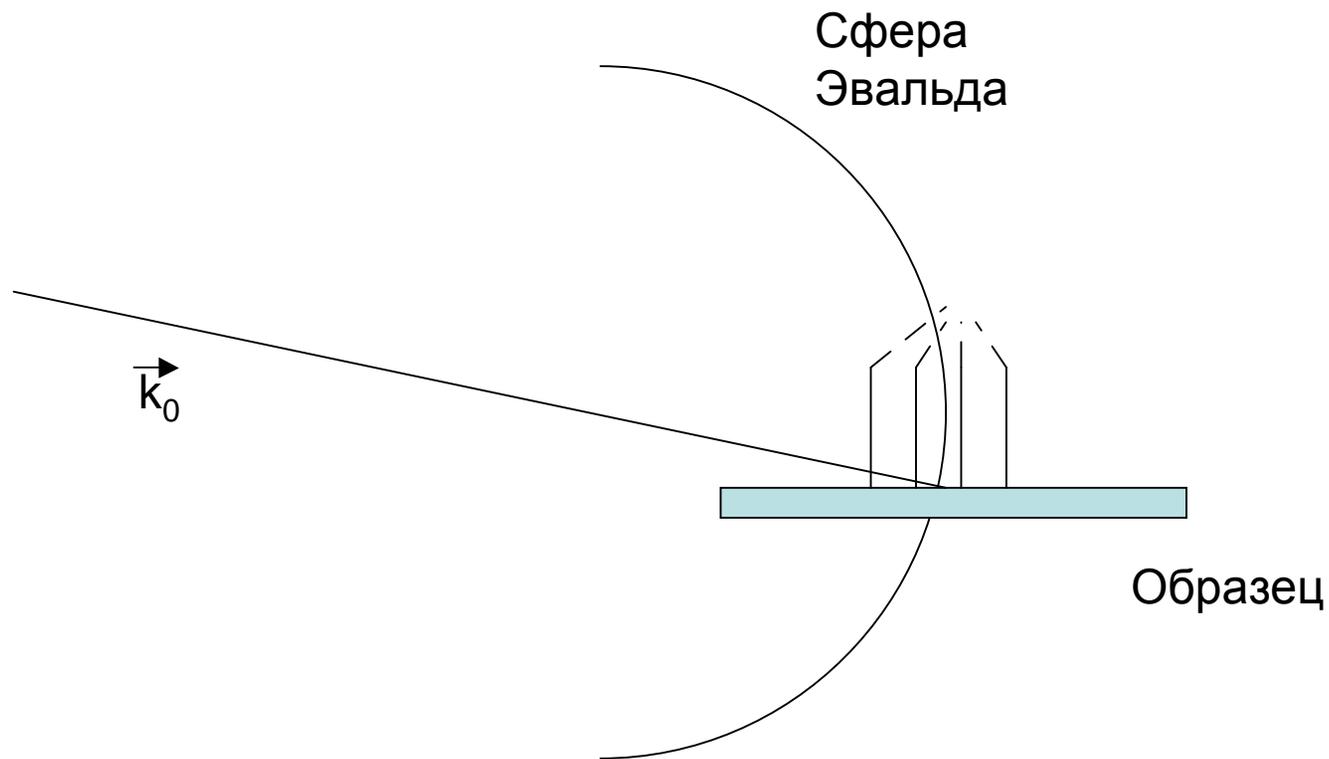
# Модификация поверхности монокристалла GaAs

С. Шаповал, лекции по  
нанотехнологии

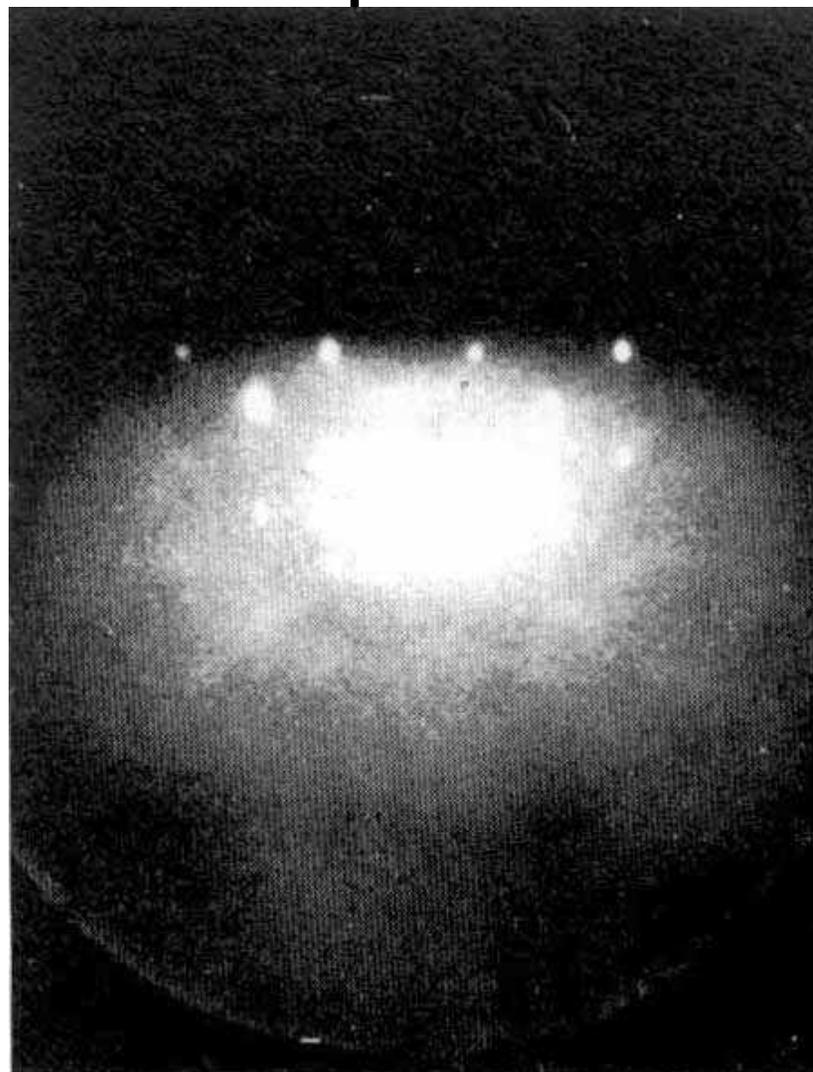
# Дифракция быстрых электронов



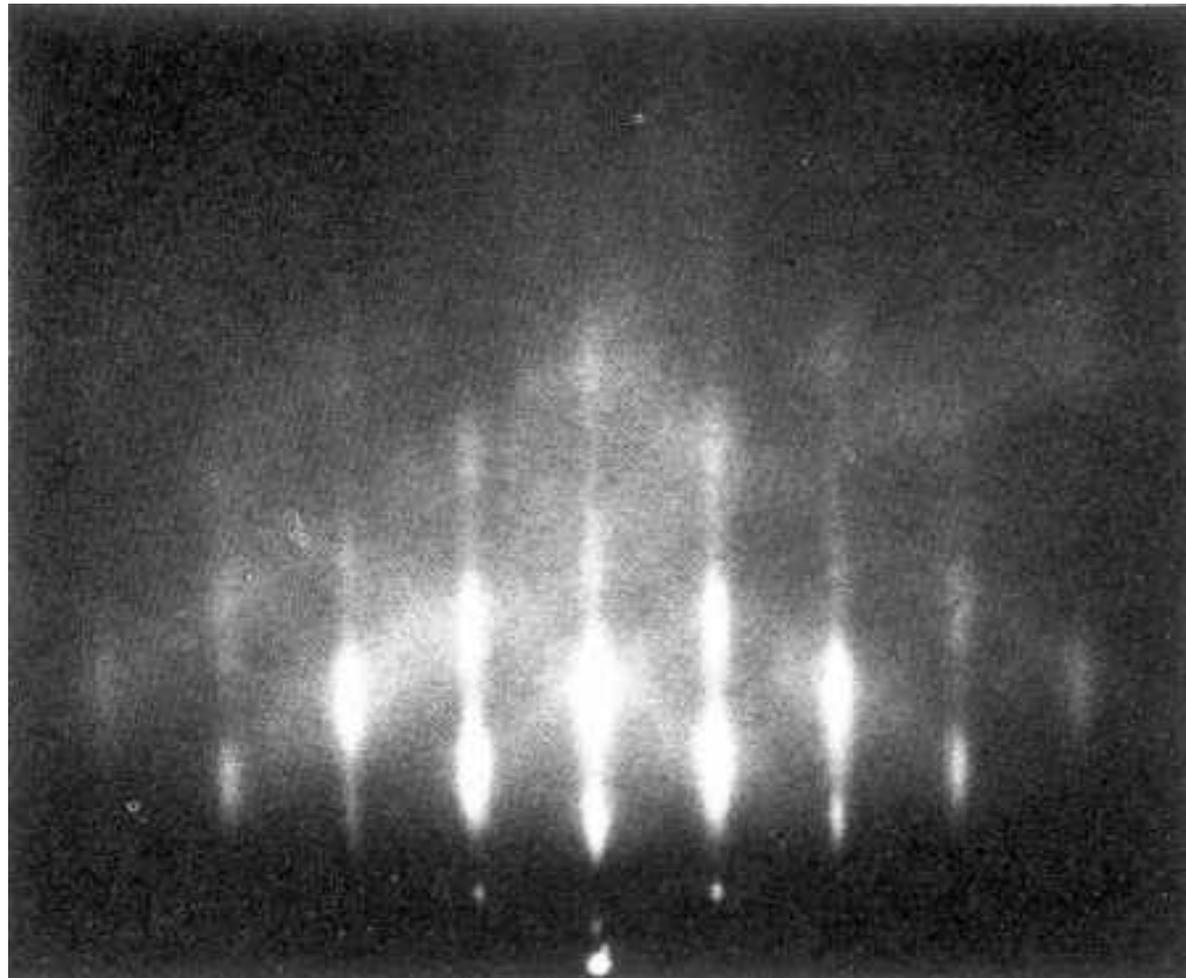
# Сфера Эвальда. Предельно гладкая поверхность монокристалла



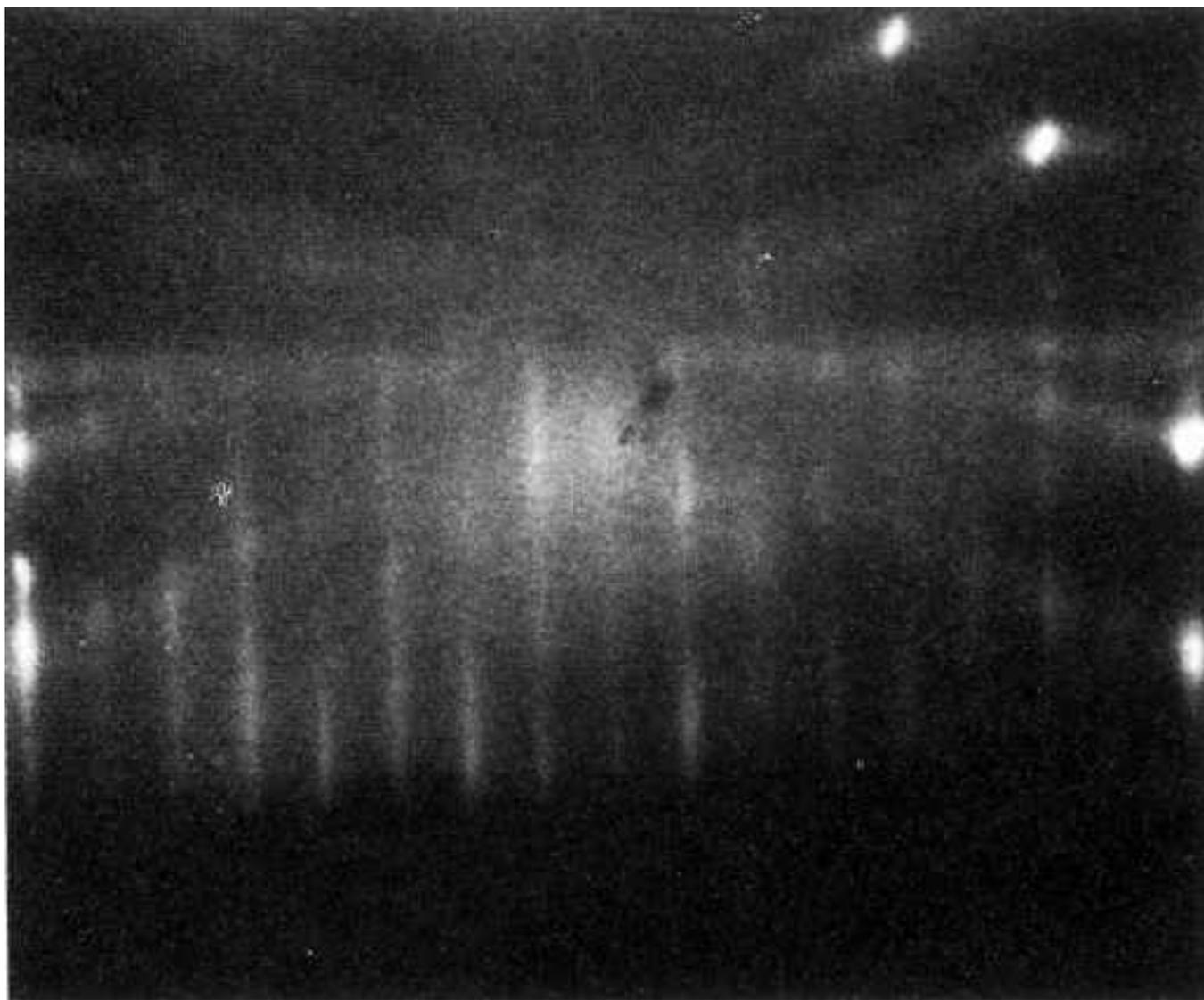
35 кВ ДБЭ (100) поверхности GaAs  
после жидкостной химической  
обработки



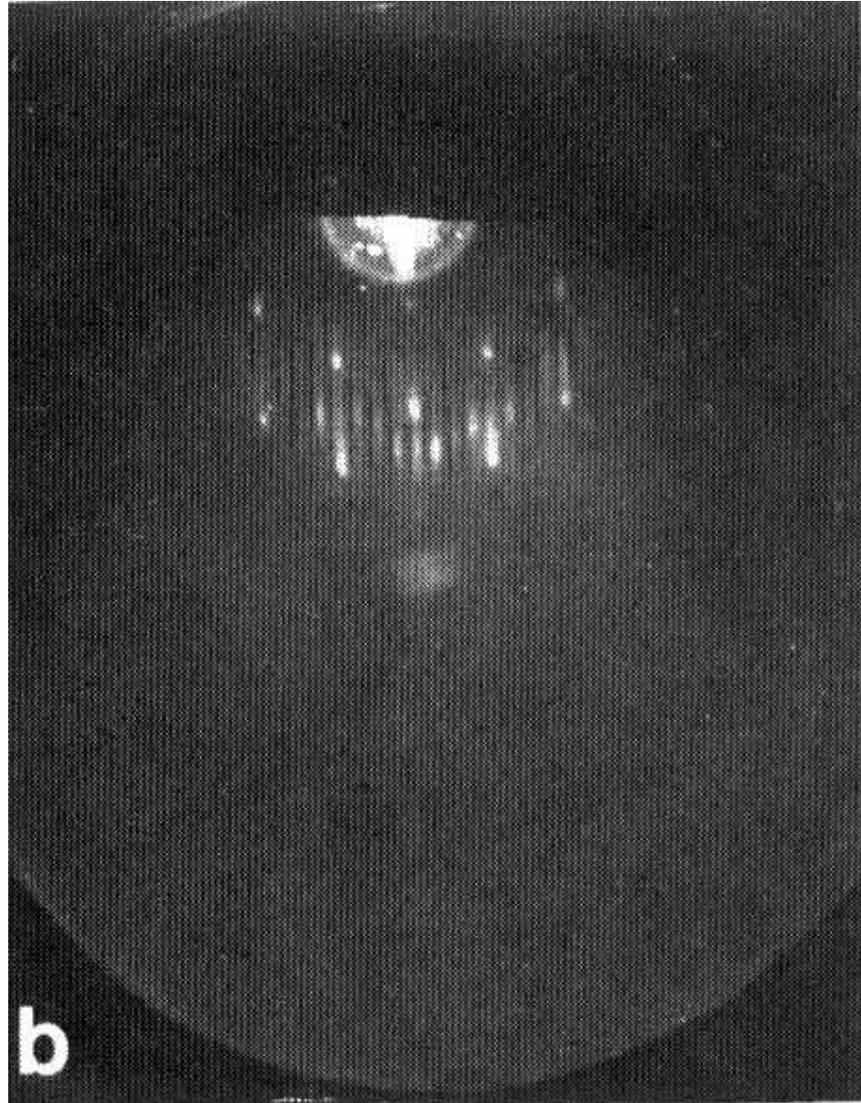
Поверхность (100) GaAs после  
прогрева. Поверхность грубая,  
субструктура не видна



Поверхность (100) GaAs после  
нескольких минут роста (МЛЭ).  
Дифракция от субструктуры (2x8)

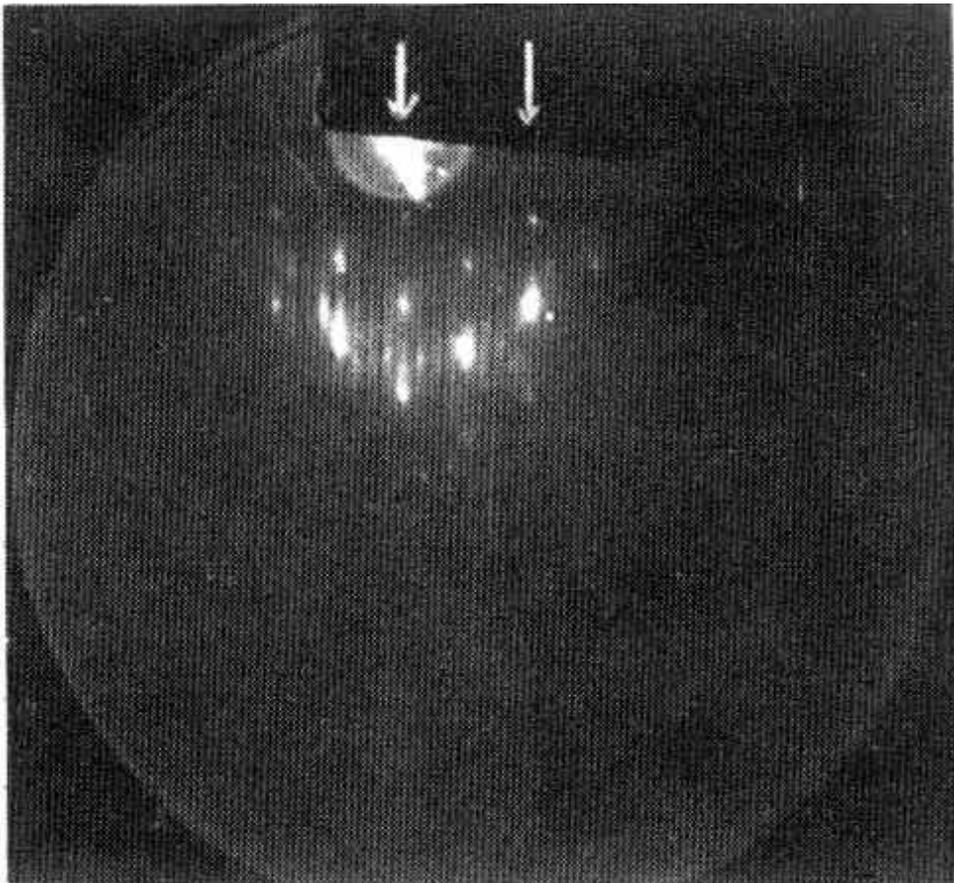


# Поверхность (100) GaAs после МЛЭ 1000 А

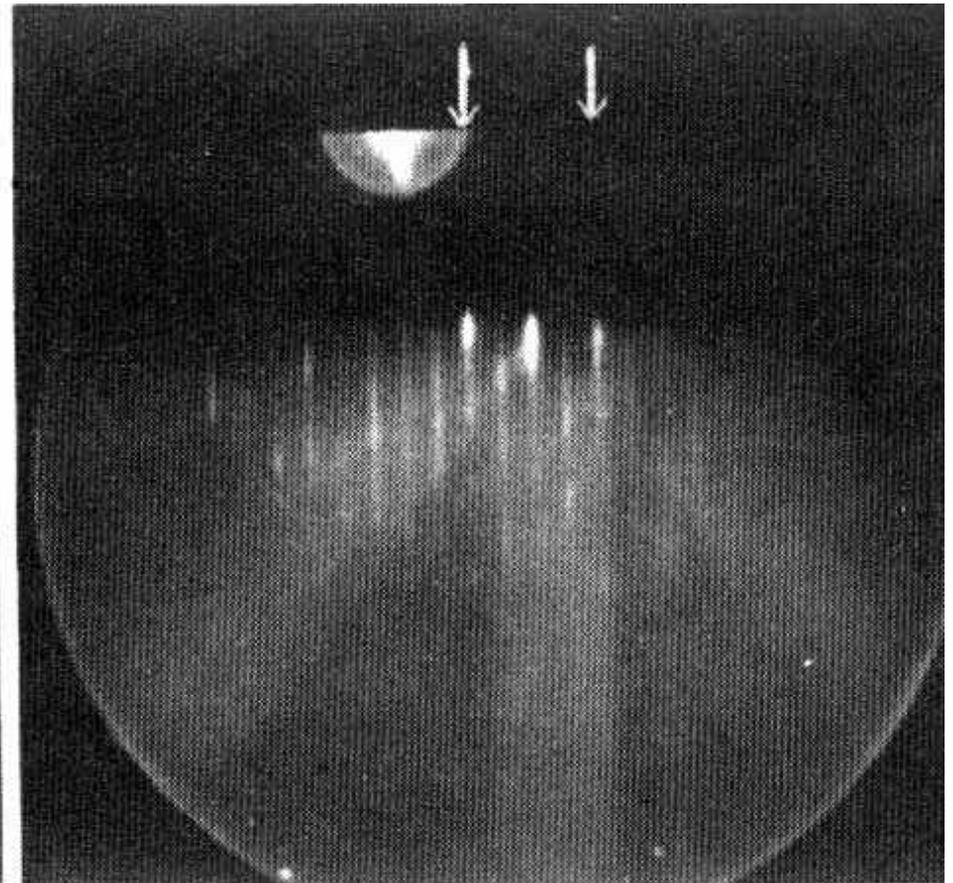


(100) GaAs, стабилизированная Ga  
поверхность, субструктура (8x2)

$[\bar{1} \bar{1} 0]$

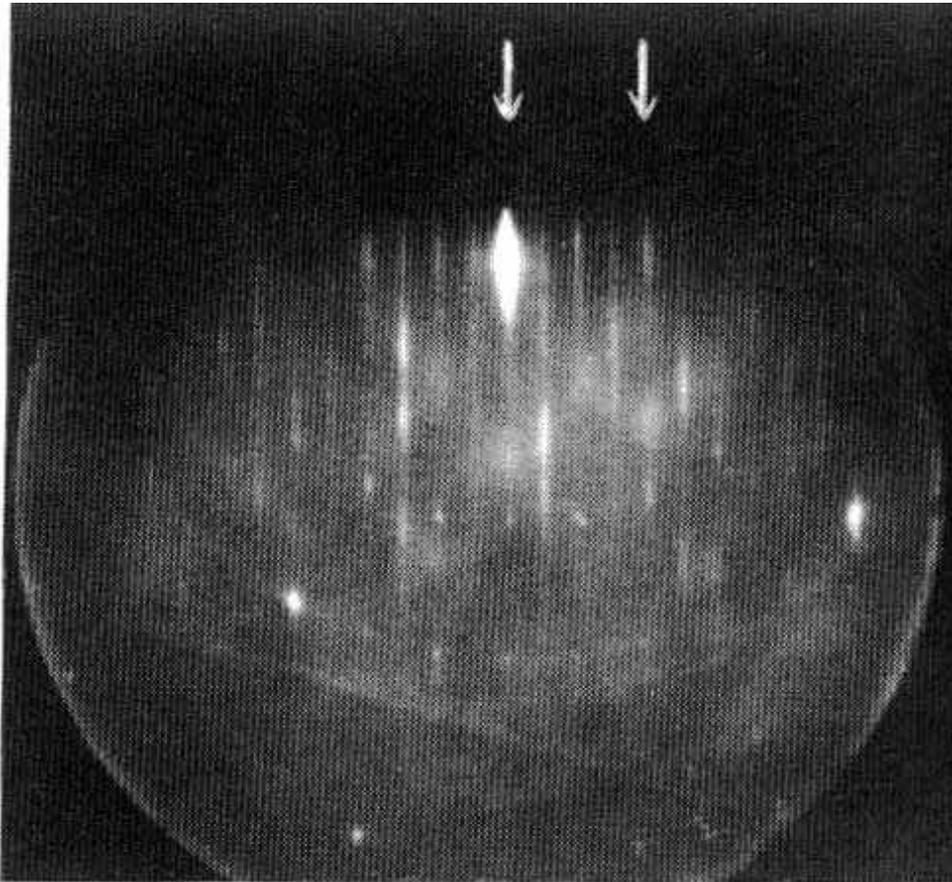


$[1 \bar{1} 0]$

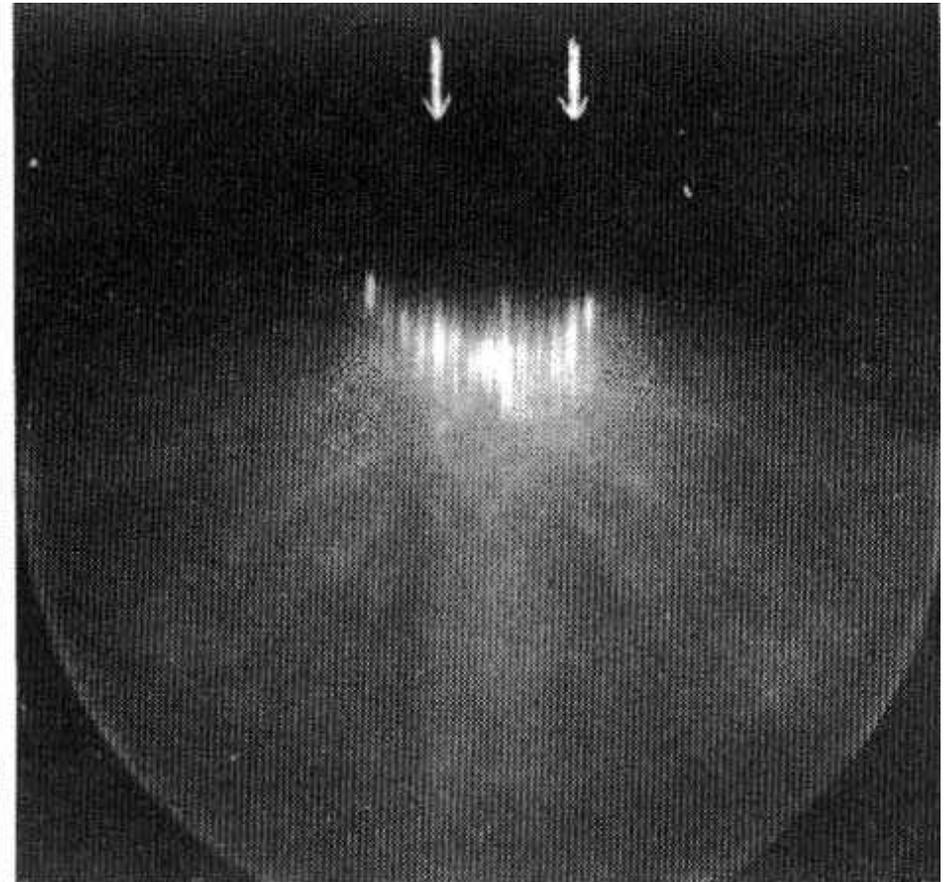


(100) GaAs, стабилизированная As  
поверхность, субструктура (2x8)

$[\bar{1} \bar{1} 0]$

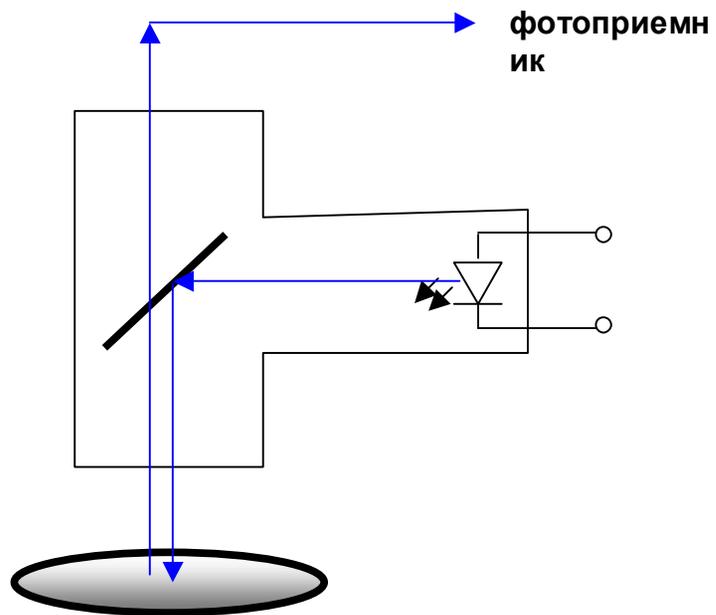
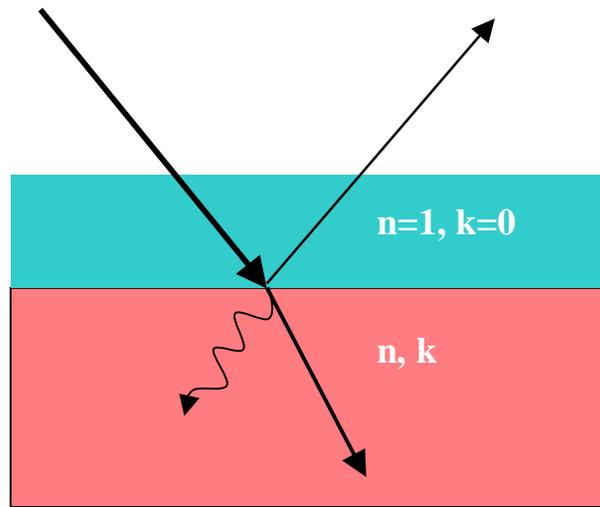


$[1 \bar{1} 0]$

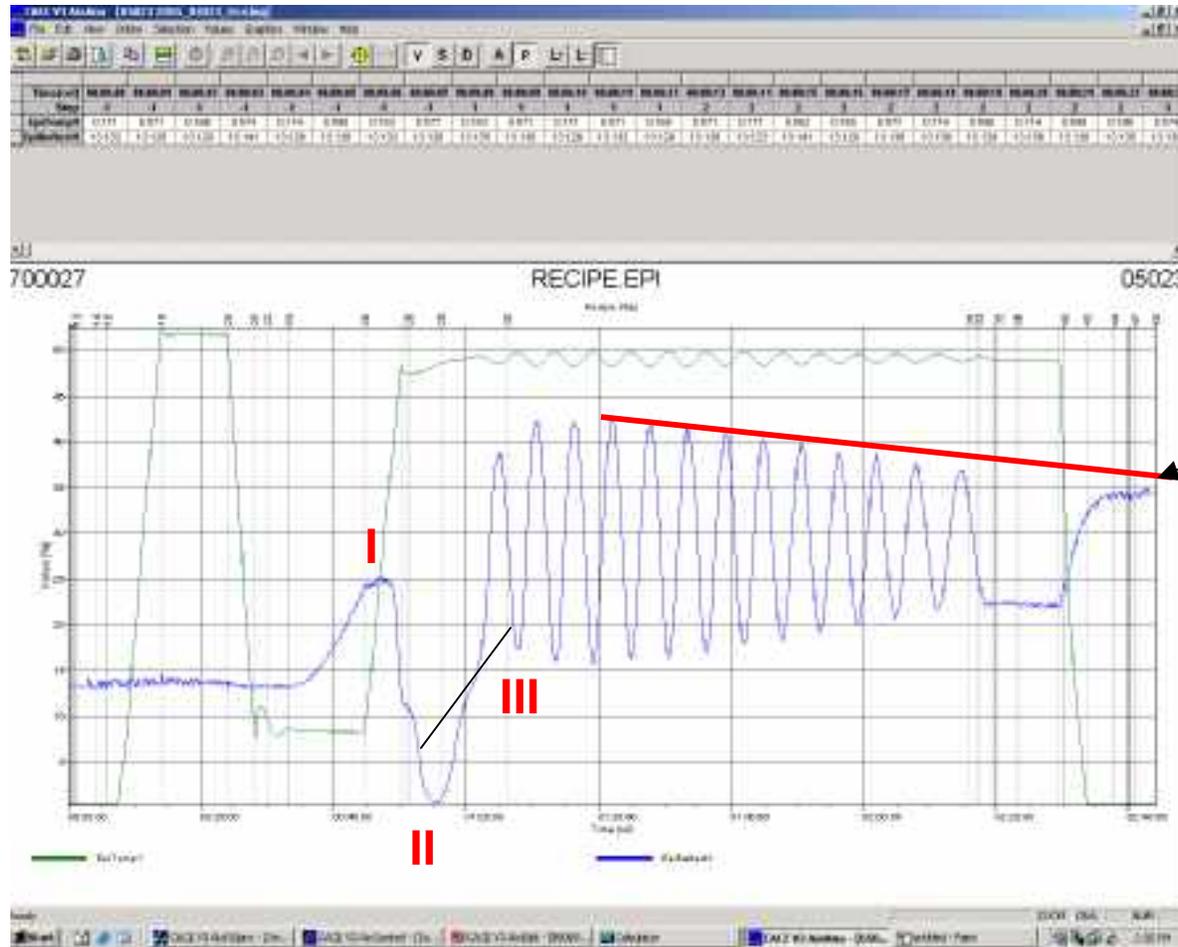


Пример реализации перехода с  
трехмерного на двумерный рост  
при эпитаксии нитрида галлия

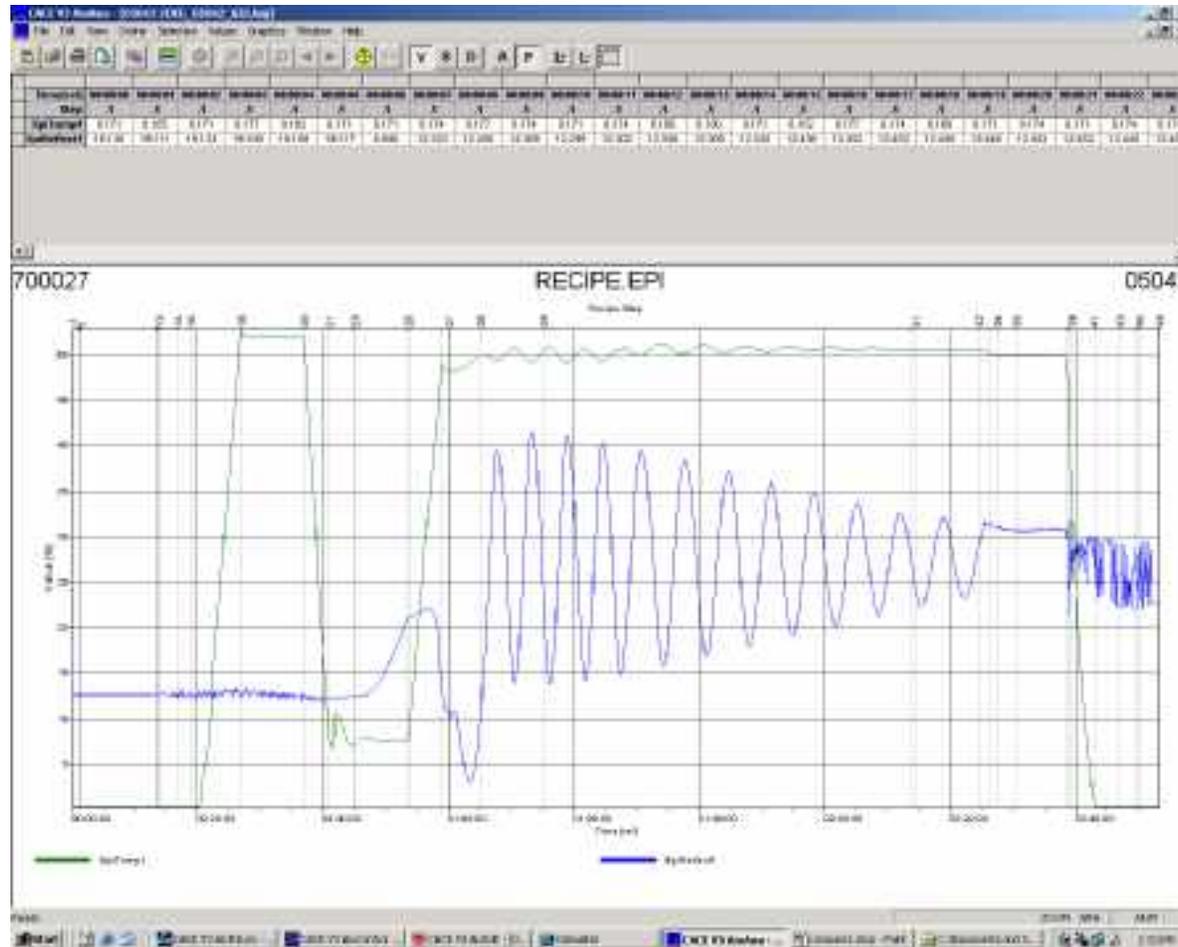
# Схема метода измерения



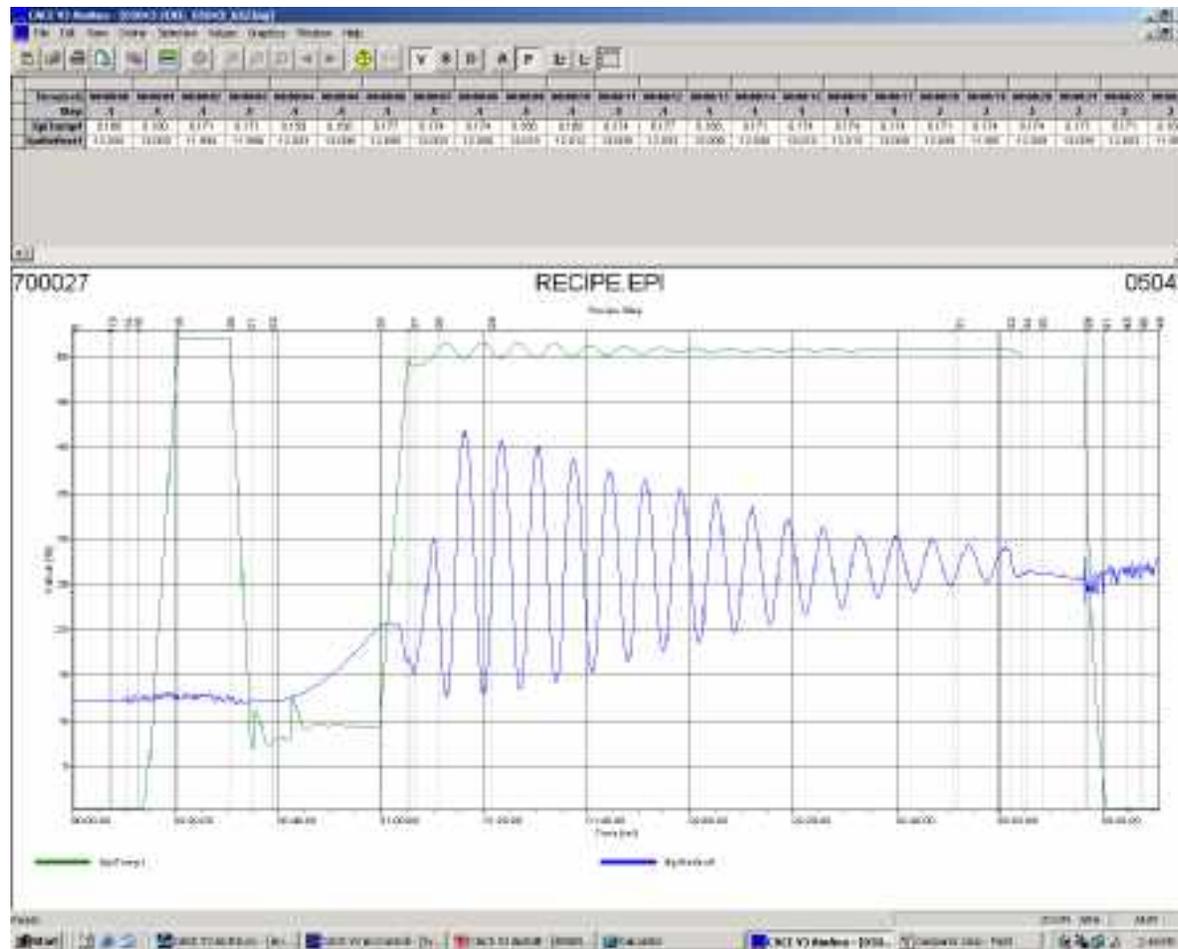
# Модификация механизма роста



# Модификация механизма роста

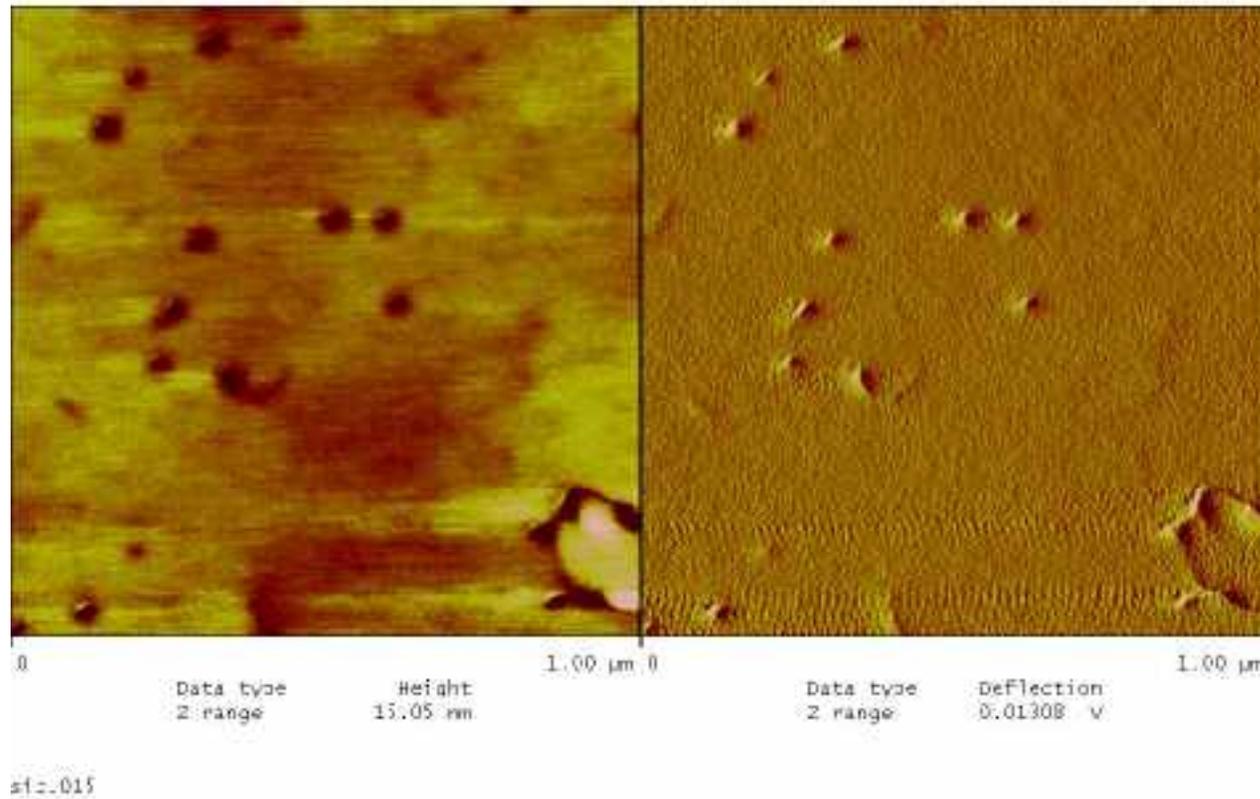


# Модификация механизма роста





# Морфология поверхности



# Морфология поверхности

